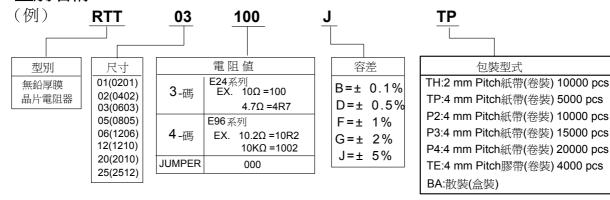
厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	1/20

1 適用範圍:

本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之RTT系列厚膜晶片電阻器。

2 型別名稱:



3 規格表:

3.1 阻值範圍:≥1Ω

	V. 1 / 上 匠 轮 图 · 三 1 2 2											
			最高	T.C.R		阻值	範圍			PER Ω)	JUM (0)	
型別	額定	最高額		(ppm/℃)					額定電流		阻	值
	功率	定電壓	電壓	温度係數	B(± 0.1%) E-24 \ E-96	D(± 0.5%) E-24 \ E-96	F(± 1%) E-24 \ E-96	G(± 2%) J(± 5%) E-24	J (± 5%)	F (± 1%)	J (± 5%)	F (± 1%)
RTT01	1	05)/	50) (± 600		$1\Omega \leq R < 25\Omega$	$1\Omega \leq R < 25\Omega$	1Ω≦R<25Ω	0.54	0.54	50m Ω	$35 \text{m}\Omega$
(0201)	20 W	25V	50V	± 250		$25\Omega \le R \le 10M\Omega$	25Ω≦R≦10MΩ	$25\Omega \leq R \leq 10M\Omega$	0.5A	0.5A	MAX.	MAX.
				± 100	100Ω≦R≦1MΩ	$100\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	100Ω≦R≦1MΩ	100Ω ≦R≦1MΩ				
(0402)	1 16 w	50V	100V	± 200		$10\Omega \leq R < 100\Omega$	$\begin{array}{l} 10\Omega \leqq R \!<\! 100\Omega \\ 1M \!<\! R \!\leqq\! 10M\Omega \end{array}$	$\begin{array}{l} 10\Omega {\leq} R \!<\! 100\Omega \\ 1M \!<\! R \!\leq\! 20M\Omega \end{array}$	1A	1.5A	$\begin{array}{c} \text{50m}\Omega\\ \text{MAX}. \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{20m}\Omega\\ \text{MAX}. \end{array}$
				+500 -200			$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$				
RTT03	1			± 100	$100\Omega \le R \le 1M\Omega$	$100\Omega \le R \le 1M\Omega$	$33\Omega \le R \le 1M\Omega$				50m Ω	20mΩ
(0603)	10 w	75V	150V	± 200		$1\Omega \leq R < 100\Omega$	$1\Omega \le R < 33\Omega$ $1M < R \le 10M\Omega$	$1\Omega \le R \le 20M\Omega$	1A	2A	MAX.	MAX.
RTT05	1	150V	300V	± 100	$100\Omega \leq R \leq 1M\Omega$	$100\Omega \le R \le 1M\Omega$	$33\Omega \le R \le 1M\Omega$		2.4	2.54	50m Ω	20m Ω
(0805)	8 W			± 200		$1\Omega \leq R < 100\Omega$	$\begin{array}{c} 1\Omega \leqq R < 33\Omega \\ 1M < R \leqq 10M\Omega \end{array}$	$1\Omega\!\leq\!R\!\leq\!20M\Omega$	2A	2.5A	MAX.	MAX.
RTT06	1	0.5		± 100	$100\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$	$100\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$	$33\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$				50 mΩ	20m Ω
(1206)	4 W	200V	400V	± 200		$1\Omega \leq R < 100\Omega$	$\begin{array}{c} 1\Omega \leqq \mathbf{R} < 33\Omega \\ \mathbf{1M} < \mathbf{R} \leqq \mathbf{10M}\Omega \end{array}$	$1\Omega\!\leq\!R\!\leq\!20M\Omega$	2A	3.5A	MAX.	MAX.
				± 100	$100\Omega \le R \le 1M\Omega$	$33\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$	$33\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$					
RTT12 (1210)	1 w	200V	400V	± 200			$\begin{array}{c} 10\Omega \leqq R < 33\Omega \\ 1M < R \leqq 10M\Omega \end{array}$	$10\Omega \leq R \leq 20M\Omega$	2A	4A	$\begin{array}{c} \text{50m}\Omega\\ \text{MAX}. \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{20m}\Omega\\ \text{MAX}. \end{array}$
(,	[± 400			$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$			1	
DTTAA	2			± 100	$100\Omega \le R \le 1M\Omega$	$33\Omega \le R \le 1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$					
(2010)	3 4 w	200V	400V	± 200				$10\Omega \le R \le 10M\Omega$	2A	5A	50m Ω	20m Ω
(2010)	4		<u></u>	± 400			$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$	<u> </u>			
DTTA				± 100	$100\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$	$33\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$	$10\Omega\!\leq\!R\!\leq\!1M\Omega$					
RTT25 (2512)	1 W	200V	400V	± 200				$10\Omega \le R \le 10M\Omega$	2A	7A	50m Ω	20m Ω
(2012)				± 400			$1\Omega \leq R < 10\Omega$	$1\Omega \leq R < 10\Omega$				
	使用溫	度範圍				-55°C ~ +′	155℃ (0 <mark>201:</mark> -	–55℃ ~ +125	°C)			

核准制級級





備註

非發行管制文件自行注意版本更新

非經允許,禁止自行影印文件。

發行管制章 DATA Center.

序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次2/20

3.2 阻值範圍:<1Ω

U.Z III	且則且.\	22				
71 71	額定	最高	最高	T.C.R (ppm / °C)	阻值範圍	
型別	功率	額定電流	過負荷電流	温度係數	F(± 1%) \ G(± 2%) \ J((± 5%) E-24 \ E-96	
				± 600	$80 \leq R < 200 \text{ m}\Omega$	
RTT02	1/16W	0.88A	2.2A	± 300	200 \leq R $<$ 400 m Ω	
(0402)	17 10 0 0	U.00A	2.2A	± 250	$400 \leq R < 600 \text{ m}\Omega$	
				± 200	600 \leq R<1000 mΩ	
				± 600	60 \leq R<100 m Ω	
RTT03	1/10W	1.29A	3.22A	± 300	100 \leq R<200 m Ω	
(0603)	1/1000	1.29A	3.22A	± 600	$200 \leq R < 500 \text{ m}\Omega$	
			ļ	± 400	$500 \leq R < 1000 \text{ m}\Omega$	
				± 1500	10 \leq R<19 mΩ	
DTT05			Ţ	± 1200	19 \leq R<33 mΩ	
RTT05 (0805)	1/8W	3.53A	8.82A	± 800	33 ≤R<50 m Ω	
(0000)				± 600	50 ≦R<100 mΩ	
				± 200	100 ≦R<1000 mΩ	
				± 1500	10 ≦R<19 mΩ	
DTTOO			'A 14.42A	± 1200	19 \leq R<25 mΩ	
RTT06	1/3W	5.77A		± 1000	25 \leq R < 50 m Ω	
(1206)				± 600	50 ≦R<100 mΩ	
				± 200	100 \leq R<1000 mΩ	
				± 1500	10 ≦R<19 mΩ	
DTT40				± 1000	19 \leq R<25 mΩ	
RTT12 (1210)	1/2W	7.07A	17.67A	17.67A	± 700	25 \leq R<50 mΩ
(1210)				± 400	50 ≦R<100 mΩ	
				± 200	100 ≦R<1000 mΩ	
				± 1500	10 ≤R<19 m Ω	
DTTOO				± 1200	19 \leq R < 25 m Ω	
RTT20 (2010)	3/4W	8.66A	21.65A	± 900	25 ≤R<50 m Ω	
(2010)				± 500	$50 \leq R < 100 \text{ m}\Omega$	
				± 200	100 \leq R<1000 mΩ	
				± 1500	10 ≤R<19 m Ω	
DTTOE				± 1200	19 \leq R < 25 m Ω	
RTT25	1 W	10A	25A	± 900	25 ≤R<50 m Ω	
(2512)				± 500	50 ≦R<100 mΩ	
				± 200	100 ≤R<1000 m Ω	
	使	用溫度範圍		-	–55℃ ~ +155℃	
(人) (些人) 和 (<u> </u>	

備	非 發 行 管 制 文 件	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

旺 詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	3/20

3.3 功率衰減曲線:

0.0		
型別	RTT01 (0201)	其它
使用 溫度範圍	-55°C ~ +125°C	−55°C ~ +155°C
說明	周圍溫度若超過70℃至125℃之間,功率可照 下圖曲線予以修定之。	周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下圖曲線予以修定之。
功率衰減曲線圖	100 負 80 載 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環境溫度(°C)	100 負 80 載 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環境溫度(℃)

3.4 額定電壓或額定電流:

3.4.1 阻值範圍:≥1Ω

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。 可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時, 則以最高額定電壓為 其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)

P=額定功率(W)

 $R=公稱阻值(\Omega)$

3.4.2 阻值範圍:<1Ω

額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,則以最高額定電流為其額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

|= 額定電流(A)

P=額定功率(W)

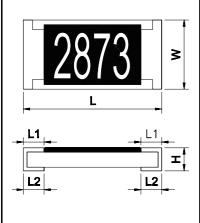
R=公稱阻值(Ω)

住言	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

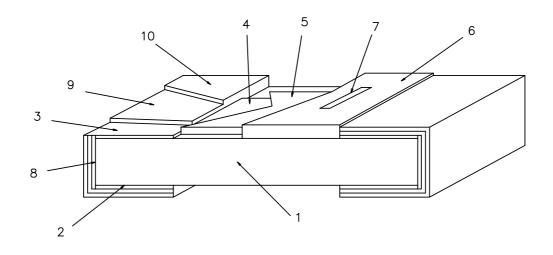
文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	4/20

4 尺寸:



					U	nit : mm
Di	mension		W	н	L1	L2
TYPE	Size Code	ı	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••		
RTT01	0201	0.60± 0.03	0.30± 0.03	0.23± 0.03	0.15± 0.05	0.15± 0.05
RTT02	0402	1.00± 0.10	0.50± 0.05	0.30± 0.05	0.20± 0.10	0.25± 0.10
RTT03	0603	1.60± 0.10	0.80± 0.10	0.45± 0.10	0.30± 0.15	0.30± 0.15
RTT05	0805	2.00± 0.10	1.25± 0.10	0.50± 0.10	0.35± 0.20	0.35± 0.15
RTT06	1206	3.05± 0.10	1.55± 0.10	0.55 +0.10 -0.05	0.45± 0.20	0.35± 0.15
RTT12	1210	3.05± 0.10	2.55± 0.10	0.55± 0.10	0.50± 0.20	0.50± 0.20
RTT20	2010	5.00± 0.20	2.50± 0.20	0.55± 0.10	0.60± 0.20	0.60± 0.20
RTT25	2512	6.30± 0.20	3.20± 0.20	0.55± 0.10	0.60± 0.20	0.60± 0.20

5 結構圖:



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

備	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	5/20

6 信賴性試驗項目:
6.1 電氣性能試驗(Flectrical Performance Test)

6.1 電氣/	生能試驗 <i>(Electrical Performance Test)</i>		<u> </u>
ITEM	Conditions	Specifications規格	生
項目	條件	Resistors	Jumper
Temperature	TCR (ppm/°C) = $\frac{(R2-R1)}{R1(T2-T1)} \times 10^6$	參考3.規格表	NA
Coefficient of			
Resistance	R1:室溫下量測之阻值(Ω)		
温度係數	R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω)		
	T1:室溫之溫度(℃)		
	T2:-55℃或+125℃之溫度(℃)。		
Short Time	依據 JIS-C5201-1 4.8 施加2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測	1 阳估额图·>1〇	公女2 担协 ‡
Overload	他加2.3倍的額及電壓O秒,靜直30分鐘以上再重測 阻值變化率。(額定電壓值請參考 3.規格表)	$0.1\% \cdot 0.5\% \cdot 1\%$:± $(1.0\% + 0.05\Omega)$	參考3.規格表
	1	2%、5%:± (2.0%+0.10Ω) 2.阻值範圍:<1Ω	
72.1112 X 11	型別 RTT01 RTT02 RTT03 RTT05 RTT06 RTT12 RTT20 RTT25	2.阻值配阻.<122 1%、2%、5%:± (2.0%+0.001Ω)	
	Jumper (0201) (0402) (0603) (0805) (1206) (1210) (2010) (2512)		0
	± 5% 1.25A 2.5A 2.5A 5A 5A 5A 5A		
	± 1% 1.25A 3.75A 5A 6.25A 8.75A 10A 12.5A 17.5A		
Insulation	依據 JIS-C5201-1 4.13 將晶片電阻置於治具上,在正負極施加100 VDC-分鐘後	>10 ⁹ O	
Resistance	測量電極與保護層及電極與基板(底材)之絕緣電阻值。	≥ 10 22	
絕緣電阻試驗	依據 JIS-C5201-1 4.6		
	絕緣材質		
	電阻背面 B 測試點		
	屋力弾簧		
	印刷保護層面 晶片電阻 ————		
Dielectric	RO.5mm 將晶片電阻置於治具上,在正、負極施加VAC	無短路或燒毀現象。	
Withstand	(參考下列)		
Villistaria	RTT05、06、12、20、25 用500 VAC-分鐘		
絕緣耐電壓	RTT01、02、03用300 VAC-分鐘		
	依據 JIS-C5201-1 4.7		
Intermittent	置於恆溫箱中,施加2.5倍額定電壓,1秒ON,	1.阻值範圍:≧1Ω	參考3.規格表
Overload	25秒OFF,計 10,000 +400 次取出靜置60分鐘後量	$\pm (5.0\% + 0.10\Omega)$	
斷續過負荷	測阻值變化量。	2.阻值範圍:<10	
	Jumper:施加最高過負荷電流:	$\pm (5.0\% + 0.001\Omega)$	
	型別 PTT01 PTT02 PTT03 PTT05 PTT06 PTT12 PTT20 PTT25		
	Jumper (0201) (0402) (0603) (0805) (1206) (1210) (2010) (2512)		
	± 5% 1.25A 2.5A 2.5A 5A 5A 5A 5A		
	<u>+ 1% 1.25A 3.75A 5A 6.25A 8.75A 10A 12.5A 17.5A </u> 依據 JIS-C5201-1 4.13		
Noise Level	依據 JIS-C5201-1 4.13 依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	電阻(Resistance) 雜音(Noise)	NA
雑音測驗	N	R <100Ω ≤-10db(0.32 uV/V)	11/7
		$\begin{array}{c cc} 100\Omega \leq R < 1K\Omega & \leq 0 db(1.0 \text{ uV/V}) \\ \hline 1K\Omega \leq R < 10K\Omega & \leq 10 db(3.2 \text{ uV/V}) \end{array}$	
		$10K\Omega \le R < 100K\Omega \le 15db(5.6 \text{ uV/V})$	
		$\begin{array}{c c} 100K\Omega \leq R < 1M\Omega & \leq 20db(10 \text{ uV/V}) \\ \hline 1M\Omega \leq R & \leq 30db(32 \text{ uV/V}) \end{array}$	
	,		
714			
備	非發行管制文件	發行管制章 D	ATA Center.

備	// ×	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號 IE-SP-007 2009/06/08 版本日期 頁 次 6/20

6.2 機械	性能試驗(Mechanical Performance Test)		
ITEM	Conditions	Specifications	規格
項目	條件	Resistors	Jumper
Core body strength 本體強度	使用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N { 1.02 kgf } 的負載持續10 sec.。 1.RTT02、RTT03測試探針R0.2 2.RTT05、06、12、20、25測試探針R0.5 依據 JIS-C5201-1 4.15	1.阻值範圍:≥1Ω ± (1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω ± (1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷,側導無裂痕	参考3.規格表
Solvent	測試項目一:將電阻焊在電路板上,在電阻背面施以5N的力量持續10 sec後,檢查側導體外觀。(RTT01:3N) 測試項目二:將電阻焊在電路板上,逐漸施加力量於電阻背面,測試端電極最大剝離強度。 依據 JIS-C5201-1 4.16 浸於20~25℃異丙醇溶劑中5± 0.5分鐘後,取出靜置48 hr以上,再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.29	項目一:外觀無損傷,無側導	参考3.規格表
11 12 M	10.10 00.20 1 1 1.20	2.阻值範圍: < 1Ω ± (1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷,無G2保護層及 Leaching現象。	
Soldering	前處理 將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、濕度100%及氣壓1.22× 10⁵ pa的飽和條件下進行4小時的老化測試,取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法 ③測試項目一(焊錫爐測試): 將電阻浸於235± 5℃之爐中2± 0.5秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 ④測試項目二(小球平衡法): 將浸漬助焊劑後的電阻置放於Wetting Balance測試機,依下列條件做設定,並記錄晶片電阻焊錫潤濕時間。 焊錫槽平衡法測試條件 「保件」 「保持	Zero Cross Time在3秒內分 1.阻值範圍:≧1Ω △R%=± (1.0%+0.05Ω)	
Heat 抗焊錫熱	,並於每一步驟間元件應置於30℃和濕度70%,或較低的條件下2小時以上。	 2.阻值範圍:<1Ω △R%=± (1.0%+0.001Ω) 電極外觀無異常,無側導脫。 	交 。
備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制:	章 DATA Center.
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:6	0

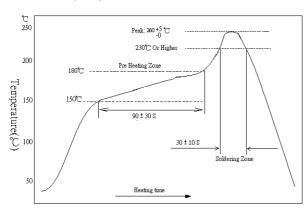
厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次7/20

ITEM	Conditions	Specifications規格	
項目	條件	Resistors	Jumper

步驟	製程名稱	試驗環境條件
1	阻值量測	室溫
2	烘乾	125℃, 24小時
3	濕潤	85℃,85%,168小時
4	Reflow(1)	Reflow溫度曲線及元件表面溫度 Table1
5	濕潤	85℃,65%,24小時
6	Reflow(2)	Reflow溫度曲線及元件表面溫度 Table2
7	阻值量測	室溫

1.Reflow溫度曲線



2.元件表面温度

Table 1規格文件說明(1)

溫度保留時間:高 於或等於230℃	尖峰溫度	測試元件表面溫度 在前製程
30秒	240 ℃	150 至160℃

Table 2規格文件說明(2)

溫度	溫度保留 時間	測試元件表面溫度 在前製程
高於或等於220℃	90秒	150至160℃
高於或等於230℃	60秒	
高於或等於240℃	5秒	
尖峰溫度	245 ℃	

◎測試方法二(焊錫爐測試):

晶片電阻於取出後,應依順序完成下列步驟之試驗 ,並於每一步驟間元件應置於30℃和濕度70%,或 較低的條件下2小時以上。

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	A Center.
註 自行注意版本更新	
# 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非 經 允 許 , 禁止自 行 影 印 文 件。	

旺 詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次8/20

TEM	
項目	ITEM
步驟 製程名稱 試驗環境條件 1 阻值量測 室溫 2 烘乾 125℃, 24小時 3 濕潤 85℃, 85%RH, 168小時 4 焊錫爐 260± 3℃,10秒 5 靜置 室溫 6 焊錫爐 260± 3℃,10秒 7 阻值量測 室溫 ②測試方法三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350± 10℃	
取電絡鏡,為熱於電極雨端後,取出靜置60分鐘以上 · 再量測阻值變化率。 依據 SONY (SS-00254-5) 依據 JIS-C5201-1 4.18 可 Solder 焊錫結合強度	項目 Joint Strength of Solder
備 非 發 行 管 制 文 件 發行管制章 DATA Cente	供

備註

非發行管制文件自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

非經允許,禁止自行影印文件。

序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次9/20

		A A	3120
ITEM	Conditions	Specifications規格	文
項目	條件	Resistors	Jumper
	Resistor Testing circuit board Solder Supporting jig Chip resistor		
	Pressurize D (Amount of bend) OHM Meter		
	依據JIS-C5201-1 4.33		
	◎測試項目三(耐久性測試): 將晶片電阻經Table 1條件之溫度循環試驗1000± 4次後,再分別根據測試項目一及測試項目二之方 法以50%條件作測試,量測阻值變化率並計算前後 變化率的誤差。		
	Table 1 温度循環測試條件		
	測試條件		
	最低溫度 -35± 5℃ 最高溫度 105± 5℃		
	温度保留時間 15 分鐘		
	依據 SONY (SS-00254-7)		
Leaching 試驗	將晶片電阻浸於助焊劑中,再將晶片電阻完全浸置於 焊錫槽內,溫度設定260±5℃、時間30+1/-0秒,取 出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 依據SONY (SS-00254-9)	2.在電極邊緣處不應見到下層的物板)。	物質(例如白基
Vibration 耐振性試驗	將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波 震動頻率:10 Hz~55 Hz~10 Hz/分 振幅:1.5 mm 測試時間:6 hr (X.Y.Z3個方向各2 hr) 依據 JIS-C5201-1 4.22	1.阻值範圍:≥1 Ω 0.1%、0.5%、1%:± (0.5%+0.05Ω) 2%、5%:± (1.0%+0.05Ω) 2. 阻值範圍:<1 Ω 1%、2%、5%:± (1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷	参考3.規格表
	<u> </u>	/1 附 灬 / 只 / 勿	

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次10/20

6.3 環境試驗(Environmental Test)

6.3 環境詞	試驗(Environmental Test)		
ITEM	Conditions	Specifications規格	
項目	條件	Resistors	Jumper
Resistance to	置於155± 5℃之烤箱中1000+48/-0 hr,取出靜置1	1.阻值範圍:≧1Ω	參考3.規格表
	hr以上再量測阻值變化率。	$0.1\% \cdot 0.5\% \cdot 1\%:\pm (1.0\% + 0.05\Omega)$ $2\% \cdot 5\%:\pm (2.0\% + 0.10\Omega)$	
	PS:RTT01置於125± 3℃中。	2.阻值範圍:<1Ω	
	依據 JIS-C5201-1 4.25	1% × 2% × 5% :± (1.0% + 0.001Ω)	
·		外觀無損傷,無短路及燒毀現象。	6 40 12 15 4
	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中,溫度為-55℃ 15分	1.阻值範圍:≧1Ω 0.1%、0.5%、1%:± (0.5%+0.05Ω)	參考3.規格表
	鐘,+125℃ 15分鐘,共計循環300次後取出,靜置	2% \ 5%: \pm (1.0% \pm 0.05Ω)	
冷熱沖擊	60分鐘再量測阻值變化率。 測試條件	2.阻值範圍:<1Ω	
	-55± 5℃	1%、2%、5%:± (1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。	
	最高溫度 125± 5℃	月	
	温度保留時間 15 分鐘		
	依據 MIL-STD 202 Method 107		
Loading Life	置於溫度40± 2℃相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中,	1.阻值範圍:≧1Ω	參考3.規格表
	並施加額定電壓,90分鐘ON,30分鐘OFF,共	型別 RTT01 其它	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1,000 hr取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。	1%:± (1.0%+0.05Ω) 0.1%、0.5%、1%: 5%:± (3.0%+0.1Ω) ± (0.5%+0.05Ω)	
	依據 JIS-C5201-1 4.24	2%、5%:	
		<u>± (2.0%+0.10Ω)</u> 2.阻值範圍: <1Ω	
		1% · 2% · 5% :± (2.0% + 0.001 Ω)	
		外觀無損傷,無短路及燒毀現象。	
	置於70± 2℃之烤箱中施加額定電壓,90分鐘ON,	1.阻值範圍:≧1Ω 型別 RTT01 其它	參考3.規格表
	30分鐘OFF,共1,000 hr取出靜置60分鐘以上再量	型別 RTT01 其它 1%:± (1.0%+0.05Ω) 0.1%、0.5%、1%:	
	測阻值變化率。 以上 US 05004 4 4 05	_{兹周} 5%:± (3.0%+0.1Ω) ± (0.5%+0.05Ω)	
	依據 JIS-C5201-1 4.25	2% · 5%: ± (2.0%+0.10Ω)	
		2.阻值範圍:<1Ω	
		$1\% \times 2\% \times 5\% : \pm (2.0\% + 0.001\Omega)$	
Low	將晶片電阻放置-55°C恆溫箱中60分鐘,施加額定電	外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 1.阻值範圍:≥1Ω	⇔ 49 担 抄 ≠
	府酯万电阻放直-330亿位温相中60分鲤,他加额足电 壓45分鐘,停止施壓15分鐘取出後靜置8± 1 hr再量	$0.1\% \cdot 0.5\% \cdot 1\%$:± $(0.5\% + 0.05\Omega)$	參考3.規格表
	型中5万壁、行正地图10万壁水山设府值01 1111行里 測阻值變化率。	2% · 5%:± (1.0%+0.05Ω)	
	依據MIL-R-55342D 4.7.4	2.阻值範圍:<1Ω 1%、2%、5%:± (1.0%+0.001Ω)	
1547300 4714 11		外觀無損傷,無短路及燒毀現象。	
Whisker試驗	晶片電阻可化分為下面二種測試:	Whisker長度在50μm之內。	
	◎測試項目一(冷熱衝擊測試):	,	
	將晶片電阻置放於冷熱衝擊試驗箱內,並依下列條件做		
	測試,試驗後置於室溫下2小時。		
	Table 1溫度循環測試條件 最低儲存溫度 -40± 2℃		
	最低儲存溫度 -40± 2℃ 最高儲存溫度 85± 2℃		
	温度保留時間 7 分		
	温度循環次數 1,500		
	◎測試項目二(耐濕性測試):		
	將晶片電阻置放於恆溫恆濕箱內,並依下列條件做測試		
	,試驗後置於室溫下2小時。 Table 2工繼始溫麻鄉溫麻始測試條供		
	Table 2不變的溫度與濕度的測試條件 溫度 85℃		
	温度 85% RH		
	測試時間 500± 4小時		
713			

備	\(\lambda \) \(發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

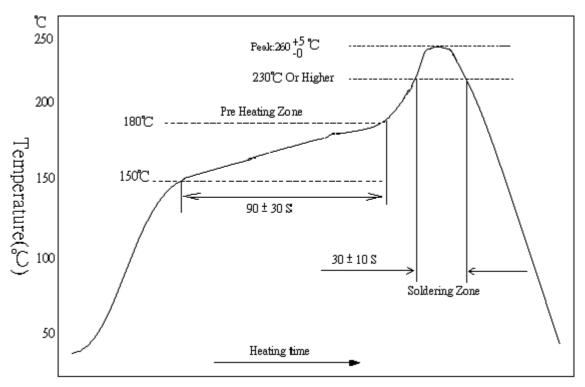
厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	11/20

ITEM	Conditions	Specifications規格	
項目	條件	Resistors	Jumper
	◎檢查 將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視察和 測試,如果此方法難做出判斷,我們可以改用掃 描電子顯微鏡(SEM),且將倍數調至1000或大於 1000倍數下做視察和測試。 依據 SONY (SS-00254-8)		

7 建議焊錫條件:

7.1 Lead Free Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫260+5/-0℃,10秒。

7.2 烙鐵焊錫方法:350± 10°C 3秒之內。

備	非發行管制文件	發行管制章 DATA Center.
註		
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

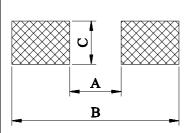
旺詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	12/20

8 建議Land Pattern Design (For Reflow Soldering):

Unit: mm



			Offic . Ithiri
DIM TYPE	Α	В	С
RTT01	0.3	1.0	0.4
RTT02	0.5	1.5	0.6
RTT03	0.8	2.1	0.9
RTT05	1.2	3.0	1.3
RTT06	2.2	4.2	1.6
RTT12	2.2	4.2	2.8
RTT20	3.5	6.1	2.8
RTT25	3.8	8.0	3.5

9 字碼表示法:

9.1 阻值範圍:≥1Ω

9.1.1 RTT03、05、06、12、20、25 ± 2%、± 5%容差:

9.1.1.1 阻值 \ge 10 Ω :以E-24系列三位數字表示,前二位數為有效數字,第三位數為乘冪(10^{x})。

《例》字碼→100

100=10 \times 100=10 Ω

9.1.1.2 阻值<10 Ω :以E-24系列三位數字表示,第一、三位數為有效數字,第二位數為乘幂 (10^{-1}) 。

《例》字碼→4R7 4R7=47 x10⁻¹=4.7Ω

9.1.2 RTT05、06、12、20、25 ± 0.1%、± 0.5%、± 1%容差:

9.1.2.1 阻值 \ge 100 Ω : 以E-24、E-96 系 列 四位數字表示,前三位數為有效數字,第四位數為乘幂 (10 x)。

《例》字碼→1002

1002=100 x10²=10000 Ω =10K Ω

9.1.2.2 阻值 < 100 Ω:以E-24、E-96 系 列四位數字表示,其中三位數為有效數字,R為乘幂(10 x)。

《例》字碼→10R2 R為乘冪(10⁻¹)

 $10R2=102 \times 10^{-1}=10.2 \Omega$

字碼→1R02 R為乘冪(10-2)

1R02=102 x10⁻²=1.02 Ω

備註	1 37 14 B 44 > E 11	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	13/20

9.1.3 RTT03 ± 0.1%、± 0.5%、± 1%、(特殊):

以E-96系列表示,不使用四字碼而使用EIAJ如下表之代碼。

前二位數為代碼,第三位數為乘冪(10^x)。

《例》字碼→47B

 $47B = 301 \times 10^{1} = 3010 \Omega = 3.01 \text{K}\Omega$

若阻值未在E-96系列而在E24系列內,則以E-24系列三字碼且底下加一橫槓表示。

阻值 ≥100Ω:字碼 391 391=39 x10¹=390Ω

阻值 <100Ω:字碼 390 390=39 x10°=39Ω

9.2 阻值範圍:<1Ω

9.2.1 RTT05、06、12、20、25 ± 1%、± 2%、± 5%容差:

9.2.1.1 阻值≥100 m Ω :以E-24、E-96系列四位數字表示,後三位數為有效數字,第一位數為乘幂(10^{-3})。

《例》字碼→R220 (E-24系列)

 $R220 = 220 \times 10^{-3} = 0.22 \Omega = 220 \text{ m}\Omega$

字碼→R102 (E-96系列)

R102=102 \times 10⁻³=0.102 Ω =102 m Ω

9.2.1.2 阻值 < 100 m Ω :以E-24系列四位數字表示,後二位數為有效數字,第一位數為乘幂 (10^3) 。

《例》字碼→R022

 $R022 = 22 \times 10^{-3} = 0.022 \Omega = 22 \text{ m}\Omega$

9.2.2 RTT03 ± 1%、± 2%、± 5%容差:

9.2.2.1 阻值≥100 m Ω :以E-24 系列三位數字表示,後二位數為有效數字,第一位數為乘幂 (10-2)。

《例》字碼→R22

 $R22=22 \times 10^{-2} = 0.22 \Omega = 220 \text{ m}\Omega$

9.2.2.2 阻值 < 100 m Ω :以E-24 系列三位數字表示,後二位數為有效數字,第一位數為乘幂 (10^{-3}) 。

《例》字碼→022

 $022 = 22 \times 10^{-3} = 0.022 \Omega = 22 \text{ m}\Omega$

9.3 RTT 0R:

產品以一字碼"0"表示。

9.4 RTT01、RTT02 無字碼表示

 排發行管制文件 自行注意版本更新
 發行管制章 DATA Center.

 非經允許,禁止自行影印文件。
 序號:60

旺 詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號IE-SP-007版本日期2009/06/08頁 次14/20

9.5 字碼表

9.5.1 E-24 系列

10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30
33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91

9.5.2 E-96 系列

. !	00 亦	71										
	100	102	105	107	110	113	115	118	121	124	127	130
	133	137	140	143	147	150	154	158	162	165	169	174
	178	182	187	191	196	200	205	210	215	221	226	232
	237	243	249	255	261	267	274	280	287	294	301	309
	316	324	332	340	348	357	365	374	383	392	402	412
	422	432	442	453	464	475	487	499	511	523	536	549
	562	576	590	604	619	634	649	665	681	698	715	732
	750	768	787	806	825	845	866	887	909	931	953	976

9.5.3 EIAJ 代碼表:

			7.76.												
代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值	代碼	阻值
01	100	13	133	25	178	37	237	49	316	61	422	73	562	85	750
02	102	14	137	26	182	38	243	50	324	62	432	74	576	86	768
03	105	15	140	27	187	39	249	51	332	63	442	75	590	87	787
04	107	16	143	28	191	40	255	52	340	64	453	76	604	88	806
05	110	17	147	29	196	41	261	53	348	65	464	77	619	89	825
06	113	18	150	30	200	42	267	54	357	66	475	78	634	90	845
07	115	19	154	31	205	43	274	55	365	67	487	79	649	91	866
08	118	20	158	32	210	44	280	56	374	68	499	80	665	92	887
09	121	21	162	33	215	45	287	57	383	69	511	81	681	93	909
10	124	22	165	34	221	46	294	58	392	70	523	82	698	94	931
11	127	23	169	35	226	47	301	59	402	71	536	83	715	95	953
12	130	24	174	36	232	48	309	60	412	72	549	84	732	96	976

 $Y=10^{-2}$ $X=10^{-1}$ $A=10^{0}$ $B=10^{1}$ $C=10^{2}$ $D=10^{3}$ $E=10^{4}$ $F=10^{5}$

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行
山上	非經允許,禁止自行影印文件。	序號

發行管制章 DATA Center.

序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	15/20

9.6 標準字碼外觀一覽表

Marking Type	А	В	С	D	E	F	Х	Υ			
0603	H	5		5	[F	X	Y			
Marking Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	R
0603		7	(7)	7	5	16	7	de			R
0805	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	2	3	T	5	6	7	8	9	0	R
1206	Spinner	2	3	7	5	6	7	9	9		R
1210	*********	2	3	3	5	6	7	8	9	0	R
2010 2512	1	2	3	7	5	6	7	8	9	0	07

10鍍層厚度:

10.1鎳層厚度:≧**1**μm

10.2純錫:≧**3** *μ* m

10.3電鍍純錫為霧錫

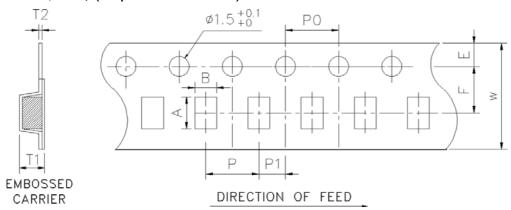
備註	1 37 14 B 44 > E 11	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

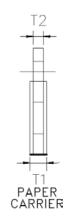
厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	16/20

11包裝:

11.1紙帶尺寸(Tape Dimensions):

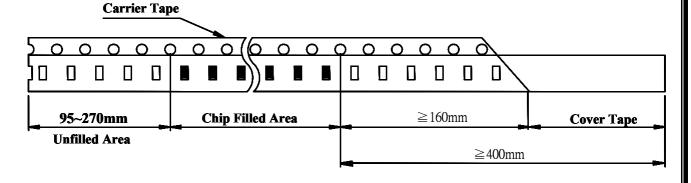




Unit: mm

Packaging	DIM TYPE	Α	В	w	E	F	T1	T2	Р	P0	10× P0	P1
(TH)	RTT01	0.68± 0.03	0.38± 0.03	8.0± 0.1	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.50± 0.05	0.32± 0.05	2.0± 0.05	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
Paper Tape	RTT02	1.15± 0.05	0.65± 0.05	8.0± 0.2	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.45+0.2/-0	0.45± 0.05	2.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.2	2.0± 0.05
	RTT03	1.80± 0.1	1.00± 0.1	8.0± 0.2	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.60+0.2/-0	0.60± 0.1	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
(TP)	RTT05	2.30± 0.1	1.55± 0.1	8.0± 0.2	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.75+0.2/-0	0.75± 0.1	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
Paper	RTT06	3.50± 0.2	1.90± 0.2	8.0± 0.2	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.75+0.2/-0	0.75± 0.1	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
Tape	RTT12	3.50± 0.2	2.80± 0.2	8.0± 0.2	1.75± 0.1	3.5± 0.05	0.75+0.2/-0	0.75± 0.1	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
	RTT20	5.50± 0.2	2.80± 0.2	12.0± 0.2	1.75± 0.1	5.5± 0.05	0.75+0.2/-0	0.75± 0.1	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
(TE)	RTT20	5.50± 0.2	2.80± 0.2	12.0± 0.2	1.75± 0.1	5.5± 0.05	0.85± 0.15	0.23± 0.15	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05
Embossed	RTT25	6.70± 0.2	3.40± 0.2	12.0± 0.2	1.75± 0.1	5.5± 0.05	0.85± 0.15	0.23± 0.15	4.0± 0.1	4.0± 0.05	40.0± 0.20	2.0± 0.05

11.2前、後導帶尺寸(Lead Dimensions):



備		發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

旺 詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

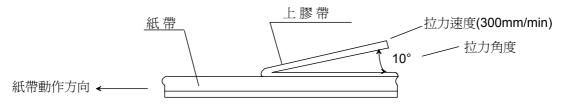
文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	17/20

11.3上膠帶剝離力量(Peel off Strength):

11.3.1規格值:0201 => 0.1 ~ 0.7N (10.2 ~ 71.4 gf)

 $0402 \Rightarrow 0.07 \sim 0.5N (7.1 \sim 51 gf)$

 $0603 \cdot 0805 \cdot 1206 \cdot 1210 \cdot 2010 \cdot 2512 \Rightarrow 0.07 \sim 0.7 \text{ N} (7.1 \sim 71.4 \text{ gf})$



11.4包裝數量(Packaging QTY):

		Packaging QTY (pcs / reel)													
TYPE	Таре		Paper									Plastic			
11	Width	2 mm Pitch						4 mm	Pitch		4 mm Pitch				
		TH	H0	H2	Н3	H4	H5	TP	P2	P3	P4	TE	E2	E3	E4
RTT01	8 mm	10,000	15,000	!	!		!	'	<u> </u>	!			'		/
RTT02	8 mm	10,000		20,000	30,000	40,000	50,000								
RTT03	8 mm														
RTT05	8 mm							5,000	10.000	15,000	20,000	1			
RTT06	8 mm							5,000	10,000	15,000	20,000				
RTT12	8 mm														
RTT20	12 mm											4,000	8 000	12 000	16,000
RTT25	12 mm	_	, 									4,000	0,000	12,000	16,000
Reel	Туре	7"	7"	10"	13"	13"	13"	7"	10"	13"	13"	7"	10"	13"	13"

TYPE	Tape Width	Bulk Case (pcs / case)	
RTT02	8 mm		50,000
RTT03	8 mm	12	25,000
RTT05	8 mm		10,000
RTT06	8 mm	36	5,000
RTT12	8 mm		
RTT20	12 mm	110	
RTT25	12 mm	- 110	

- 11.4.1典型包裝型式:TH、TP、TE
- 11.4.2其他包裝型式應客戶之需求而包裝

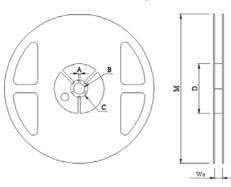
備	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	18/20

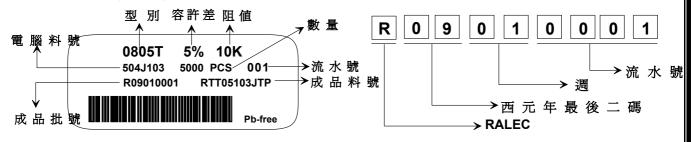
Unit: mm

11.5塑膠圓盤尺寸(Reel Dimensions):



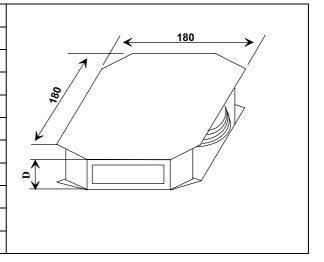
Reel Type/ Tape	Wa	M	Α	В	С	D
7" reel for 8 mm tape	9.0 ± 0.5	178 ± 2.0			21.0 ± 0.5	60.0 ± 1.0
7" reel for 12 mm tape	13.8 ± 0.5	178 ± 2.0	2.0	13.5 ± 0.5		80.0 ± 1.0
10" reel for 8 mm tape	10.0 ± 0.5	254 ± 2.0	± 0.5			100.0 ± 1.0
13" reel for 8 mm tape	10.0 ± 0.5	330 ± 2.0				100.0 ± 1.0

11.6標籤表示(Label):



11.7內 盒尺寸

内並入了				
卷數	D 尺寸(mm)			
1	12			
2	24			
3	36			
4	48			
5	60			
6	72			
7	84			
8	96			
9	108			
10	120			



備註	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

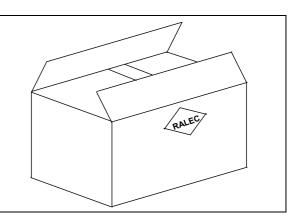
旺 詮

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	19/20

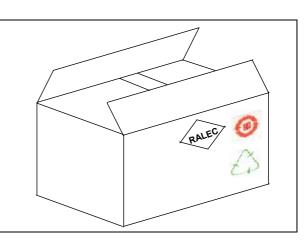
11.8外箱尺寸

10R內盒個數	長(mm)	寬(mm)	厚(mm)	
2	272	205	210	
4	375	280	210	
8	544	380	210	



11.9外銷中國大陸外箱尺寸

10R內盒個數	長(mm)	寬(mm)	厚(mm)
2	272	205	210
4	375	280	210
8	544	380	210



12阻值測試包裝標準量測位置

背面電極量測				Unit : mm
A	-	TYPE DIM	A	В
		RTT01	0.44± 0.05	0.22 ± 0.05
	RTT02	0.80± 0.05	0.24 ± 0.05	
		RTT03	1.35± 0.05	0.35 ± 0.05
	<u>-</u>)	RTT05	1.80 ± 0.05	0.35 ± 0.05
• Current Terminal	Observed Terroritani	RTT06	2.90 ± 0.05	0.35 ± 0.05
• Current Terminal	RTT12	2.90 ± 0.05	0.35 ± 0.05	
Voltage Terminal		RTT20	4.50 ± 0.05	1.15 ± 0.05
		RTT25	5.90 ± 0.05	1.60 ± 0.05

備	71 12 11	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60

厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-007
版本日期	2009/06/08
頁 次	20/20

13儲存期限

13.1在儲存環境25± 5℃、60± 15%之條件下可儲存二年。

14電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)



- 15此部份中規定,產品不使用含有RoHS指定中限制使用之有害物質的材料, 詳細內容可參考RoHS (2002/95/EC 指令)之禁用物質部份
 - 15.1鎘及鎘化合物 (允許含量<100ppm)
 - 15.2鉛及鉛化合物 (允許含量<1000ppm)
 - 15.2.1排除條款:
 - 15.2.1.1陰極射線管,電子零件及螢光燈管之玻璃中的鉛。
 - 15.2.1.2電子部件中使用的玻璃材料包括電阻,導電漿,粘著劑,玻璃料,密封料等。
 - 15.3汞及汞化合物 (允許含量<100ppm)
 - 15.4六價鉻化合物 (允許含量<100ppm)
 - 15.5聚溴聯苯 (PBB) (允許含量<100ppm)
 - 15.6聚溴二苯謎 (PBDE) (允許含量<100ppm)

16附件

16.1文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

備	1/1 1/2 1/4 = 1/4 = 1/4	發行管制章 DATA Center.
註	自行注意版本更新	
	非經允許,禁止自行影印文件。	序號:60